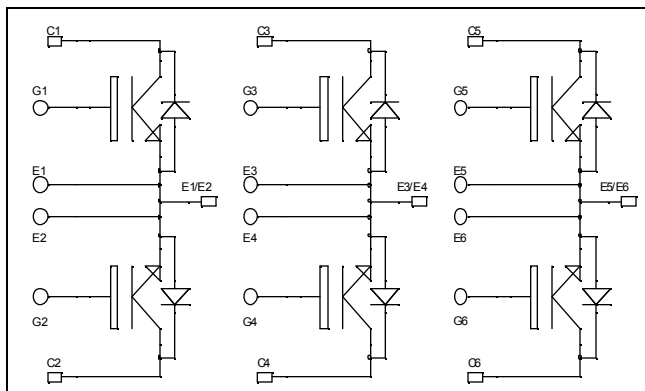


Triple Dual Common Source Trench + Field Stop IGBT® Power Module

$$V_{CES} = 600V$$

$$I_C = 150A @ T_c = 80^{\circ}C$$

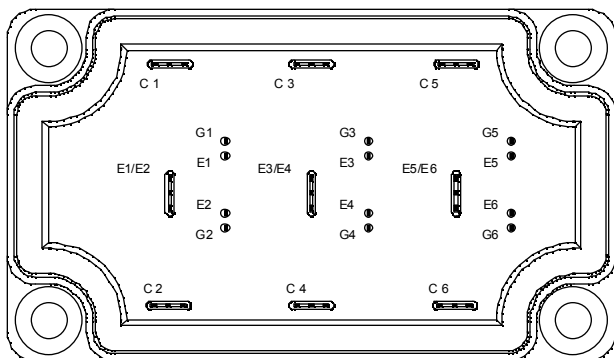


Application

- AC Switches
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies

Features

- Trench + Field Stop IGBT® Technology
 - Low voltage drop
 - Low tail current
 - Switching frequency up to 20 kHz
 - Soft recovery parallel diodes
 - Low diode VF
 - Low leakage current
 - Avalanche energy rated
 - RBSOA and SCSOA rated
- Kelvin emitter for easy drive
- Very low stray inductance
 - Symmetrical design
 - Lead frames for power connections
- High level of integration



Benefits

- Stable temperature behavior
- Very rugged
- Solderable terminals for easy PCB mounting
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Easy paralleling due to positive TC of VCEsat
- Very low (12mm) profile
- Each leg can be easily paralleled to achieve a dual common source configuration of three times the current capability
- RoHS Compliant

Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
V_{CES}	Collector - Emitter Breakdown Voltage	600	V
I_C	Continuous Collector Current	$T_C = 25^{\circ}C$	A
		$T_C = 80^{\circ}C$	
I_{CM}	Pulsed Collector Current	$T_C = 25^{\circ}C$	350
V_{GE}	Gate - Emitter Voltage	± 20	V
P_D	Maximum Power Dissipation	$T_C = 25^{\circ}C$	480
RBSOA	Reverse Bias Safe Operating Area	$T_j = 150^{\circ}C$	300A @ 550V



CAUTION: These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on www.microsemi.com

All ratings @ $T_j = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Electrical Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
I_{CES}	Zero Gate Voltage Collector Current	$V_{GE} = 0\text{V}$, $V_{CE} = 600\text{V}$			250	μA
$V_{CE(sat)}$	Collector Emitter Saturation Voltage	$V_{GE} = 15\text{V}$ $I_C = 150\text{A}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	1.5 1.7	1.9	V
$V_{GE(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GE} = V_{CE}$, $I_C = 1.5\text{ mA}$	5.0	5.8	6.5	V
I_{GES}	Gate – Emitter Leakage Current	$V_{GE} = 20\text{V}$, $V_{CE} = 0\text{V}$			400	nA

Dynamic Characteristics

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
C_{ies}	Input Capacitance	$V_{GE} = 0\text{V}$		9200		pF
C_{oes}	Output Capacitance	$V_{CE} = 25\text{V}$		580		
C_{res}	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1\text{MHz}$		270		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching (25°C) $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $V_{Bus} = 300\text{V}$ $I_C = 150\text{A}$ $R_G = 3.3\Omega$		115		ns
T_r	Rise Time			45		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			225		
T_f	Fall Time			55		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	Inductive Switching (150°C) $V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $V_{Bus} = 300\text{V}$ $I_C = 150\text{A}$ $R_G = 3.3\Omega$		130		ns
T_r	Rise Time			50		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			300		
T_f	Fall Time			70		
E_{on}	Turn on Energy	$V_{GE} = \pm 15\text{V}$ $V_{Bus} = 300\text{V}$ $I_C = 150\text{A}$ $R_G = 3.3\Omega$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	0.85 1.5		mJ
E_{off}	Turn off Energy		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	4.1 5.3		mJ

Reverse diode ratings and characteristics

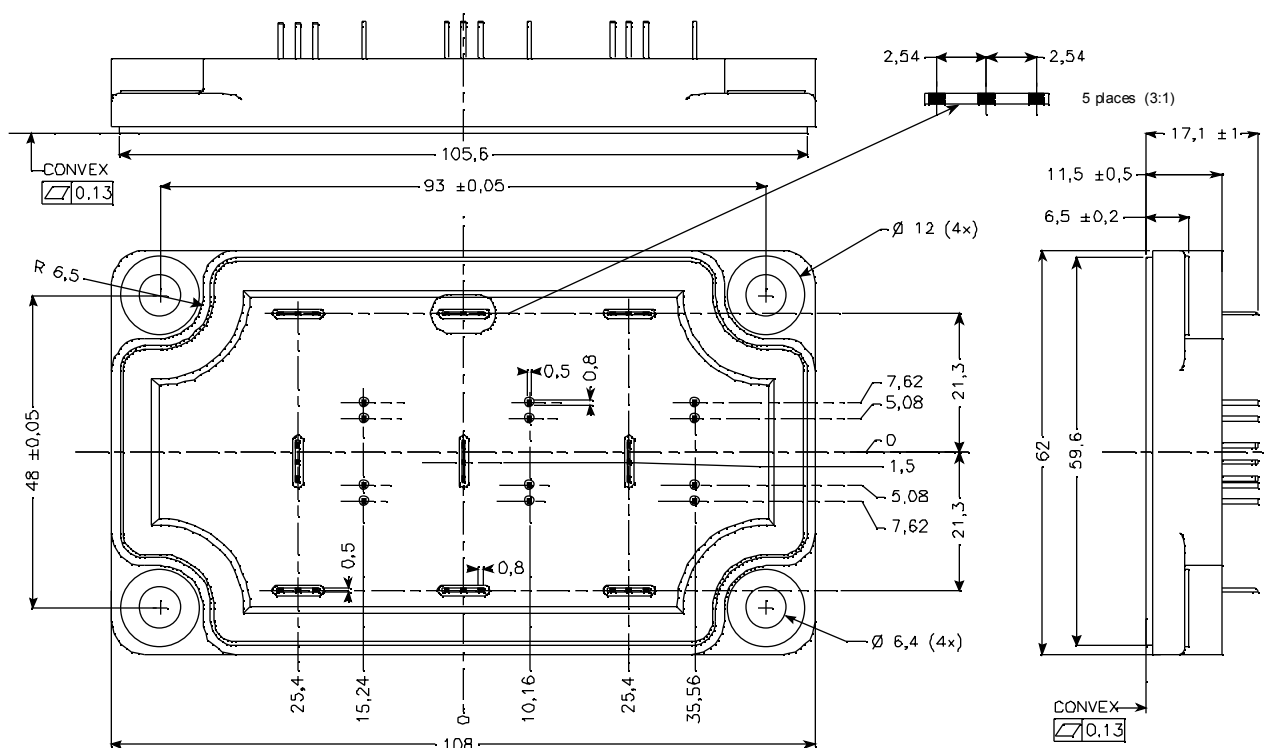
Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V_{RRM}	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		600			V
I_{RM}	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 600\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$		250 500	μA
I_F	DC Forward Current		$T_c = 80^\circ\text{C}$	150		A
V_F	Diode Forward Voltage	$I_F = 150\text{A}$ $V_{GE} = 0\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	1.6 1.5	2	V
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_F = 150\text{A}$ $V_R = 300\text{V}$ $di/dt = 3000\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	130 225		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	6.9 14.5		μC
E_r	Reverse Recovery Energy		$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 150^\circ\text{C}$	1.6 3.5		mJ

Thermal and package characteristics

Symbol Characteristic

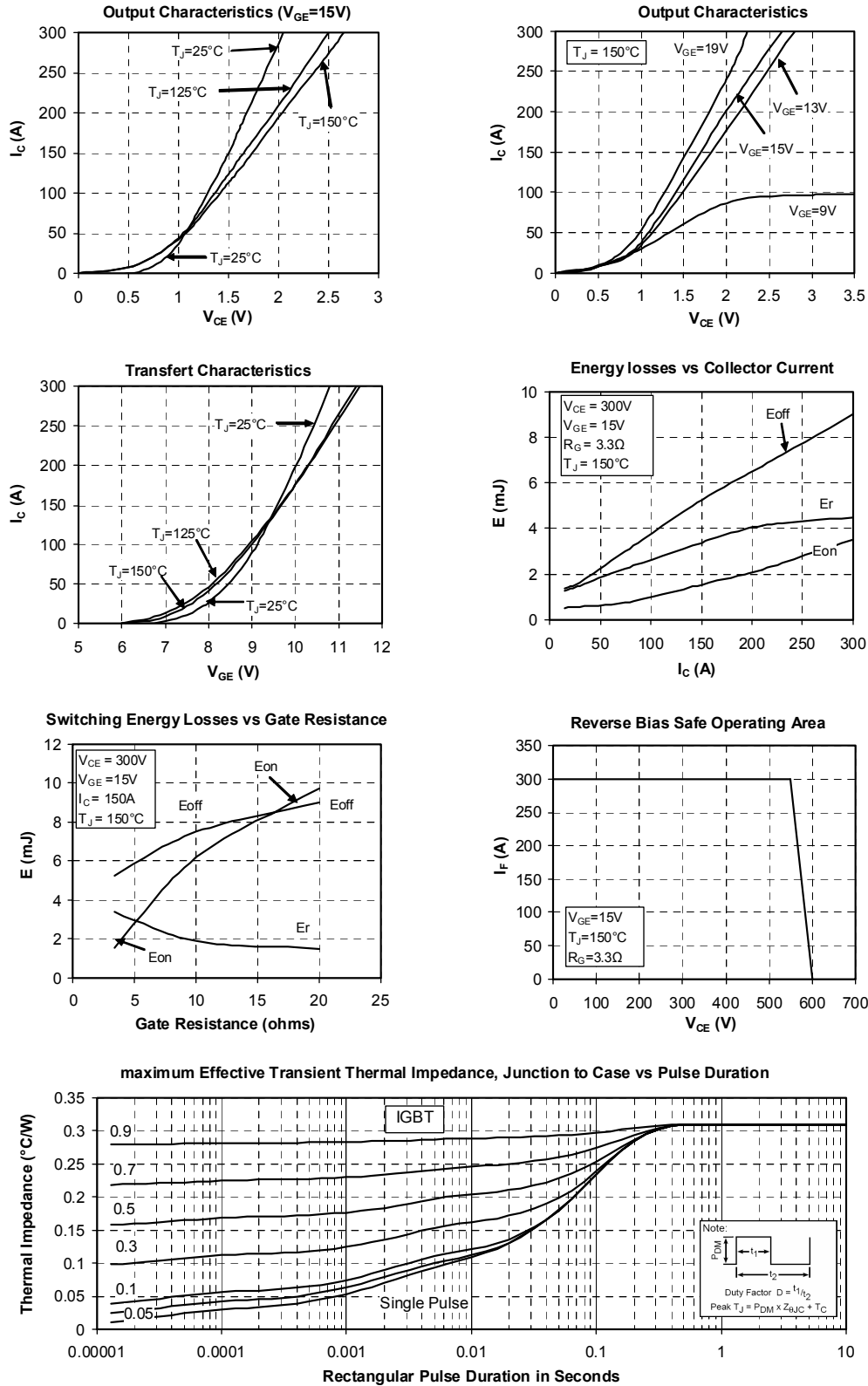
			Min	Typ	Max	Unit
R_{thJC}	Junction to Case Thermal Resistance	IGBT			0.31	°C/W
		Diode			0.52	
V_{ISOL}	RMS Isolation Voltage, any terminal to case $t = 1$ min, $I_{isol} < 1$ mA, 50/60Hz		2500			V
T_J	Operating junction temperature range		-40		175	°C
T_{STG}	Storage Temperature Range		-40		125	
T_C	Operating Case Temperature		-40		100	
Torque	Mounting torque	To heatsink	M6	3	5	N.m
Wt	Package Weight				250	g

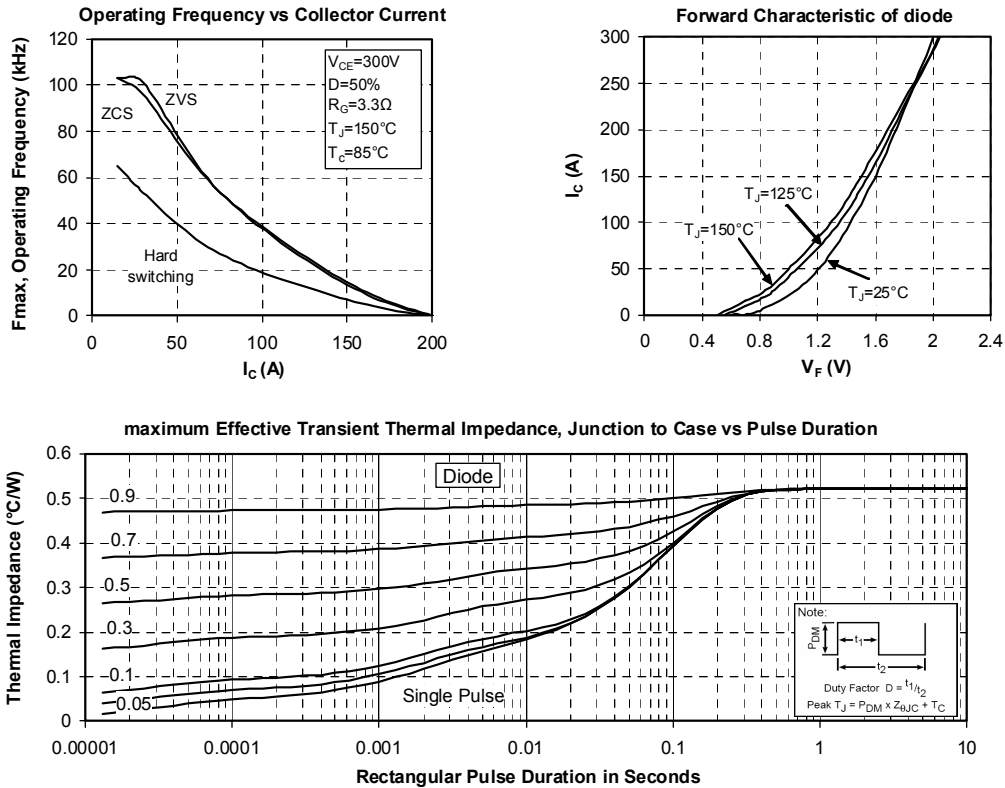
SP6-P Package outline (dimensions in mm)



See application note 1902 - Mounting Instructions for SP6-P (12mm) Power Modules on www.microsemi.com

Typical Performance Curve





Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331